

μ SMES용 초전도선의 안정성

김대선, 류경우, 김해종*, 성기철*
전남대학교, *한국전기연구소

Stability of superconducting wires for a μ SMES device

D.S. Kim, K. Ryu, H.J. Kim*, K.C. Seong*
Chonnam national univ., *KERI

Abstract - A dry winding is adopted in μ SMES devices. In these kinds of devices, MPZ and quench propagation velocity are important characteristics in the fabrication of μ SMES devices. In this paper, the influence of disturbance, Cu ratio and external field on MPZ and quench propagation velocity was investigated.

1. 서 론

에너지저장 용량이 수 MJ인 소형 초전도 에너지저장장치(이하 μ SMES장치)의 경우 고전류밀도 운전이 요구되며, 충·방전 시 발생하는 고류순실을 효과적 냉각시키기 위해서는 냉각채널을 갖는 구조로 제작 되어야 한다. 이러한 구조의 μ SMES장치에서는 여자 시 발생되는 강한 자기력에 의해 초전도선이 국부적으로 움직이게 되는 결과, 초전도선의 한 부분에서 매우 국부적으로 상전도부가 발생하게 된다. 이러한 국부적인 상전도부가 점점 성장하여 μ SMES장치 전체를 훈치시키게 된다. 따라서 μ SMES장치의 제작에 앞서 초전도선의 국부적 훈치에 의해 발생된 상전도부가 전체로 성장하지 못하도록 냉각채널의 폭을 결정해야 하며 이를 위해서 초전도선의 MPZ(minimum propagation zone: 최소 전파 영역)를 열평형 방정식으로부터 조사하였다. 또한 만약 어떤 원인에 의해 μ SMES장치 전체가 훈치될 때 장치를 소손으로부터 보호 및 μ SMES장치에 저장된 에너지를 저온 용기 외부로 신속히 방출할 때 대단히 중요한 인자인 훈치 전파속도에 관해서 조사하였다.

2. 해석모델

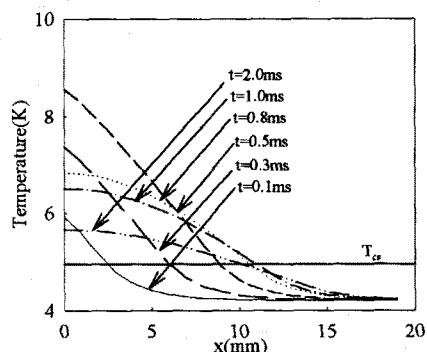
본 연구에 이용된 초전도선의 열평형 방정식은 식(1)로 표시할 수 있다(1).

$$S \frac{\partial}{\partial x} \left(k(T) \frac{\partial T}{\partial x} \right) - P q_b + S g + d = S c(T) \frac{\partial T}{\partial t} \quad (1)$$

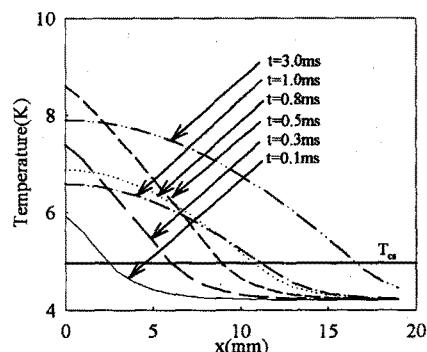
여기서 S , T , P 는 각각 초전도선의 단면적, 온도 및 냉각 주변길이, $k(T)$, $c(T)$ 는 초전도선의 유효 열전도도 및 유효 비열, q_b 는 냉매인 액체헬륨으로의 열전달 그리고 g , d 는 각각 초전도선의 주울순실 및 외란 파워를 의미한다.

그림 1은 보통 μ SMES장치를 조기 훈치시키는 국부적 외란이 초전도선에 인가되었을 때 시간에 따른 초전도선의 온도변화 추이를 외란의 대칭성을 고려하여 1/2만 나타내었다. 그림 1에서 a)는 외란 에너지가 338 μ J인 경우의 결과로써 외란 지속시간인 0.5 ms까지는 초전도선의 온도가 상승하다가 외란이 종료된 이후에는 다시 낮아져 초전도 상태로 회복됨을 나타내는 반면, b)의 경우는 외란 에너지가 a)의 경우보다 0.6 %정도 큼

에도 불구하고 초전도선의 온도는 외란이 종료된 후 짧은 시간동안 감소하다 다시 상승하여 초전도 상태로 회복되지 못하고 궁극적으로는 초전도선 전체로 훈치가 확산됨을 알 수 있다. 따라서 특정한 국부적 외란에 대해서 발생된 상전도부는 전파도 회복도 되지 않는 경계에너지가 존재함을 알 수 있고, 이를 MQE (minimum quench energy)라 하며 일반적으로 초전도선의 안정성 평가 기준으로 사용된다. 또한 이 경계에서 초전도선에 발생된 상전도부의 길이를 MPZ라 하고 μ SMES장치의 제작 시 냉각채널의 폭을 결정하는데 중요한 설계 데이터이며 본 해석에서 MPZ를 결정하는데는 초전도선의 손실이 최초로 발생하기 시작하는 온도인 분류 개시온도(T_{cs})를 사용하였으며 해석 대상으로 써는 참고문헌 [1]의 초전도선으로 하였다.



a) 회복시 외란 에너지=338 μ J



b) 훈치시 외란 에너지=340 μ J

그림 1. MQE경계에서 초전도선의 온도 분포:
 $Cu ratio=6$, $x_{ds}=1$ mm, $t_{ds}=0.5$ ms, $B=4$ T.

3. 결과 및 고찰

그림 2 - 그림 4에는 MPZ에 대한 해석 결과를 나타내었다. 그림 2는 μ SMES장치에서 빈번히 발생되는 국부적 외란이 MPZ에 미치는 영향을 조사하기 위해 MPZ와 운전전류사이의 관계를 나타낸 것으로 외란 지속시간 및 공간길이는 MPZ에 거의 영향을 미치지 않음을 알 수 있다. 또한 운전전류가 커질수록 MPZ는 짧아짐을 알 수 있고 이는 안정한 μ SMES장치를 제작하기 위해서는 장치가 고전류밀도화가 될 수록 냉각재널의 폭을 좁게 하여야만 함을 의미한다. 그림 3에는 동비가 초전도선의 MPZ에 미치는 영향을 조사하였으며, 동비가 클수록 MPZ는 길어짐을 알 수 있다. 그림 4에는 초전도선에 인가되는 외부 자장에 대한 영향을 나타내었으며, 외부자장이 클수록 MPZ도 길어지는 것을 알 수 있다.

그림 5 - 그림 8에는 μ SMES장치가 국부적으로 펜치 되었을 때 초전도선의 펜치 전파속도에 대해서 조사한 결과를 나타내었다. 그림 5에는 외란의 지속시간과 공간길이에 대한 결과를 나타내었으며, 펜치 전파속도와 외란 지속시간 및 공간길이와 거의 무관하고 운전전류가 높을수록 커진다는 것을 알 수 있었다. 그림 6에는 동비에 의한 영향을 나타내었으며, 동비가 클수록 펜치 전파속도는 느려지는 것을 알 수 있다. 그림 7에는 초전도선에 인가된 외부 자장과 펜치 전파속도와의 관계를 나타내고 있으며 외부자장이 클수록 펜치 전파속도는 느려지는 것을 알 수 있으며, 마지막으로 그림 8에는 외란 에너지가 펜치 전파속도에 미치는 영향을 나타내었고, 횡축은 초전도선에 인가한 외란 에너지를 MQE 경계에서의 외란 에너지로 정규화한 런을 의미한다. 결과로부터 초전도선의 펜치 전파속도는 외란 에너지에는 거의 무관함을 알 수 있다.

4. 결 론

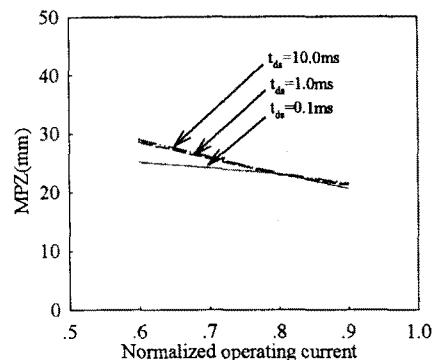
이상의 초전도선에 대한 열평형 방정식으로부터 구해진 MPZ 및 펜치 전파속도에 관한 결과를 요약하면 다음과 같다.

- 운전전류가 커질수록 MPZ는 짧아지며, 펜치 전파속도는 빨라진다.
- 외란 지속시간 및 공간길이는 MPZ 및 펜치 전파속도에 거의 영향을 미치지 않는다.
- 동비가 커질수록 MPZ는 길어지며, 펜치 전파속도는 느려진다.
- 외부 자장이 커질수록 동비의 경우와 동일하게 MPZ는 길어지고, 펜치 전파속도는 느려진다.
- 마지막으로 펜치 전파속도는 외란 에너지의 크기에 거의 무관함을 알 수 있다.

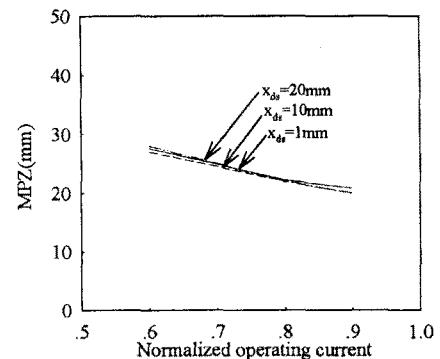
(참 고 문 헌)

- [1] 김대선, 류경우, 최병주, “고전류밀도 초전도선의 안정성”, 초전도·저온공학회 학술대회 논문집, pp.61-64, 1999.

2



a) $x_{ds} = 1 \text{ mm}$



b) $t_{ds} = 0.5 \text{ ms}$

그림 2. MPZ의 외란에 대한 영향:
 $Cu \text{ ratio}=6, B=4 \text{ T}$.

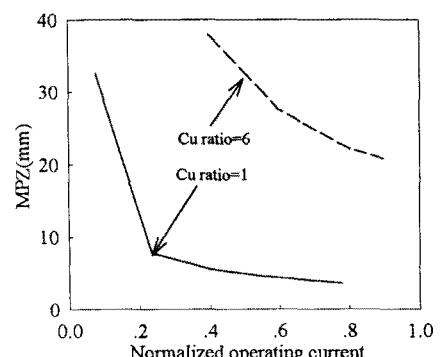


그림 3. MPZ의 동비에 대한 영향:
 $x_{ds} = 1 \text{ mm}, t_{ds} = 0.5 \text{ ms}, B = 4 \text{ T}$
 $I_{op}/I_c = 0.6$.

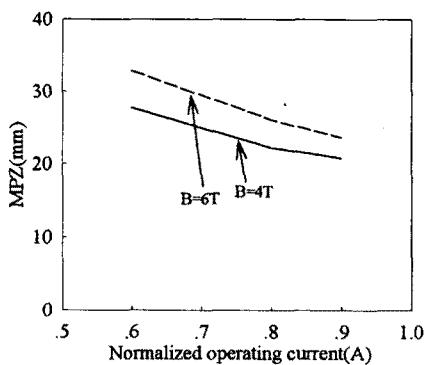


그림 4. MPZ의 외부자장에 대한 영향:
Cu ratio=6, $x_{ds}=1$ mm, $t_{ds}=0.5$ ms.

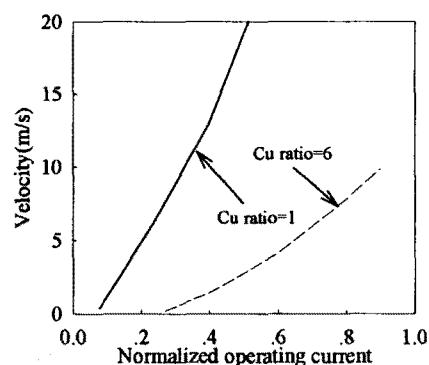
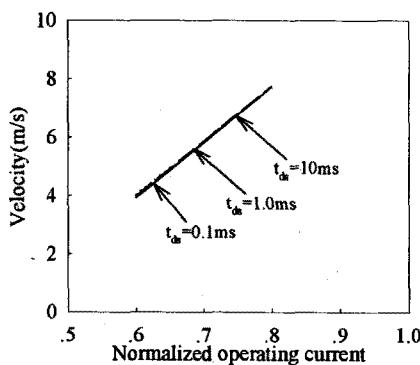


그림 6. 웨치 전파속도의 동비에 의한 영향:
 $x_{ds}=1$ mm, $t_{ds}=0.5$ ms, $B=4$ T.



a) $x_{ds}=1$ mm

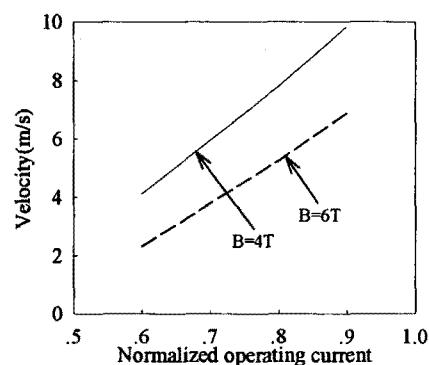
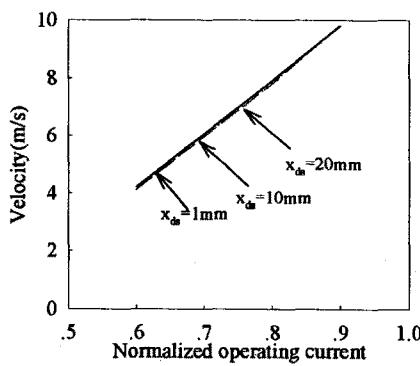


그림 7. 웨치 전파속도의 외부자장에 의한 영향:
Cu ratio=6, $x_{ds}=1$ mm, $t_{ds}=0.5$ ms.



b) $t_{ds}=0.5$ ms

그림 5. 웨치 전파속도의 외란에 의한 영향:
Cu ratio=6, $B=4$ T.

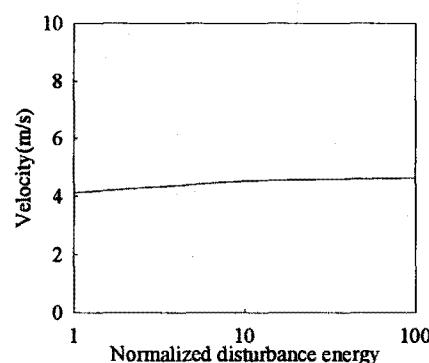


그림 8. 웨치 전파속도의 외란 에너지에 의한 영향:
Cu ratio=6, $x_{ds}=1$ mm, $t_{ds}=0.5$ ms, $B=4$ T.